

	<h2 style="color: red;">SI4446DY-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI4446DY-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4446DY-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 125909 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4446DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	125909 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 5.2A, 10V
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4446DY-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 3.9A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Ta)

SI4446DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4446DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4446DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4446DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4447ADY VISHAY SI4447ADY VISHAY</p>	 <p>SI4444-BX-FM-01A SILICON SILICON QFN</p>	 <p>SI4442DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p>SI4446DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC</p>
 <p>SI4442DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p>SI4442DY-T1-E3.. VISHAY SI4442DY-T1-E3.. VISHAY</p>	 <p>SI4442DY-T1-E3, VISHAY SI4442DY-T1-E3, VISHAY</p>	 <p>SI4446DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC</p>

SI4446DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / SI4446DY-T1-E3 Datenblatt	SI4446DY-T1-E3-Datenblätter	SI4446DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4446DY-T1-E3
Vishay				
SI4446DY-T1-E3 Electronic	SI4446DY-T1-E3-Komponenten	SI4446DY-T1-E3-Verteiler	SI4446DY-T1-E3-Bild	SI4446DY-T1-E3-Teil
SI4446DY-T1-E3 Preis	SI4446DY-T1-E3 Hersteller	SI4446DY-T1-E3 Bild	SI4446DY-T1-E3 Aktie	SI4446DY-T1-E3 Inventar
SI4446DY-T1-E3 Neu	SI4446DY-T1-E3 Original	SI4446DY-T1-E3 garantiert	SI4446DY-T1-E3 RFQ	SI4446DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited